








	<h2>SI1416EDH-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1416EDH-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT-363</p> <p>Datenblätter:  SI1416EDH-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 81392 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1416EDH-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT-363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	81392 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 3.9A (Tc) 1.56W (Ta), 2.8W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SOT-363
Verlustleistung (max)	1.56W (Ta), 2.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 3.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1416EDH-T1-GE3-ND

SI1416EDH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1416EDH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1416EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1416EDH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1414DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4A SOT-363</p>	 <p>SI1417DH-T1-E3 VISHAY SI1417DH-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI1414DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4A SOT-363</p>	 <p>SI1413EDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.3A SC-70-6</p>
 <p>SI1417DH-T1-GE3 V SI1417DH-T1-GE3 V</p>	 <p>SI1413EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.3A SC-70-6</p>	 <p>SI1417EDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 2.7A SC70-6</p>	 <p>SI1416EDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT-363</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ SI1406DH	↔ SI1406DH-T1	⇒ SI1406DH-T1-E3	D SI1406DH-T1-E3	⇒ SI1406DH-T1-GE3
⊣ SI1406DH-T1-GE3	⊗ SI1407DL	D SI1407DL-T1	⇒ SI1407DL-T1-E3	⇒ SI1407DL-T1-GE3
⊗ SI1410EDH	⊣ SI1410EDH-T1	⊗ SI1410EDH-T1-E3	↔ SI1410EDH-T1-E3	⇒ SI1410EDH-T1-GE3
D SI1413DH-T1	⊗ SI1413EDH	⊣ SI1413EDH-T1	⊗ SI1413EDH-T1-E3	⇒ SI1413EDH-T1-GE3
⇒ SI1413EDH-T1-GE3	↔ SI1413EDH-T1-GE3	⊗ SI1414DH-T1-GE3	⊣ SI1414DH-T1-GE3	⇒ SI1416EDH-T1-GE3
↔ SI1417DH-T1-E3	⇒ SI1417DH-T1-GE3	D SI1417EDH-T1	⊗ SI1417EDH-T1-E3	⊣ SI1417EDH-T1-E3
⊗ SI1417EDH-T1-GE3	D SI1417EDH-T1-GE3	⇒ SI1422DH-T1-GE3	↔ SI1422DH-T1-GE3	⇒ SI1424EDH-T1-GE3
⊣ SI1424EDH-T1-GE3	⊗ SI1426DH-T1-E3	↔ SI1426DH-T1-E3	⇒ SI1426DH-T1-GE3	⇒ SI1426DH-T1-GE3
⊗ SI1427EDH-T1-GE3	⊣ SI1427EDH-T1-GE3	⊗ SI1428EDH-T1-GE3	D SI1428EDH-T1-GE3	⇒ SI1433DH-T1
↔ SI1433DH-T1-E3	⊗ SI1433DH-T1-E3	⊣ SI1433DH-T1-GE3	⊗ SI1433DH-T1-GE3	⇒ SI1441EDH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited